

Transistor Mosfet TK18A50D Canal N à effet de champ 500V 18A 0.22ohm SC-67



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVTK18A50D
Alimentation :	Secteur Français

Transistor Mosfet TK18A50D Canal N à effet de champ 500V 18A 0.22ohm SC-67

Transistor Mosfet TK18A50D Canal N à effet de champ 500V 18A 0.22ohm SC-67

Type de canal : Canal N
 Courant de drain Id : 18A
 Type de boîtier de transistor : SC-67
 Tension de test Rds(on) : 10V
 Dissipation de puissance : 50W
 Température d'utilisation Max. : 150°C
 Tension Drain-Source Vds : 500V
 Résistance Drain-Source à l'état-ON : 0.22ohm
 Montage transistor : Traversant
 Tension de seuil Vgs Max : 4V
 Nbre de broches : 3Broche(s)

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles